

HIGH-VOLTAGE MONOLITHIC IC

ECN3061

ECN3061はIGBTを6個内蔵したワンチップ三相ブリッジICです。
特に三相DCブラシレスモータ制御用に最適です。

機能

- ・チャージポンプ回路内蔵
- ・フリーホイールダイオード内蔵

特長

- ・6入力端子をマイコン制御することによりPWM制御が可能です。
- ・6入力端子はCMOSレベルで駆動できます。
- ・6個のIGBTは20kHzにてチョッピング動作可能です。

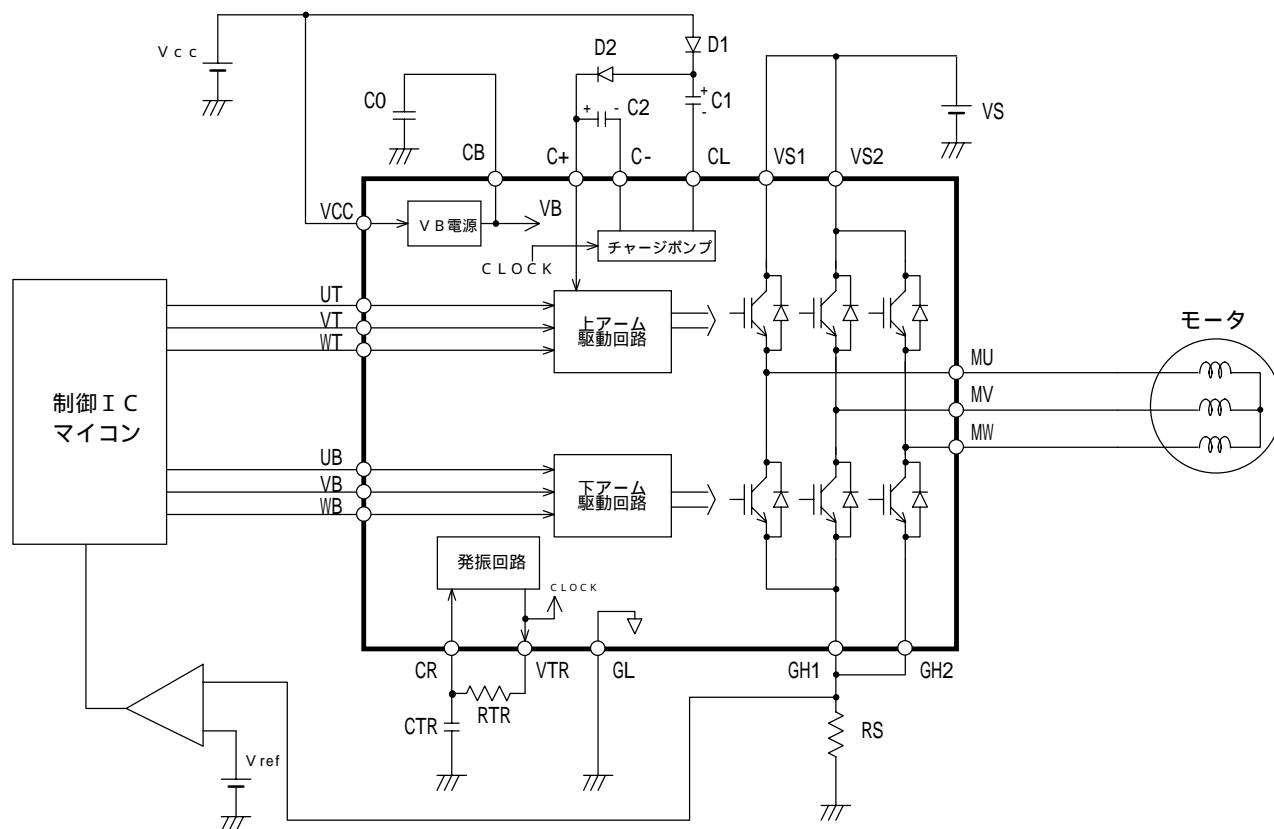


図1 . 回路ブロック図

ECN3061

1. 適用範囲

本仕様書は、下記に示す半導体集積回路に適用します。

- (1) 型式 i) ECN3061SP
 ii) ECN3061SPV
 iii) ECN3061SPR
- (2) 用途 3相DCブラシレスモータ
- (3) 構造 モノリシックIC
- (4) 外形 SP-23T

2. 最大定格 (Ta = 25)

No.	項目	記号	端子	定格値	単位	注
1	出力素子耐圧	VSM	VS1, VS2 MU, MV, MW	250	V	
2	電源電圧	VCC	VCC	18	V	
3	入力端子電圧	VIN	UT, VT, WT, UB, VB, WB	-0.5 ~ VB+0.5	V	
4	出力電流	IMDC	MU, MV, MW	1.0	A	
5	せん頭出力電流	IMP	MU, MV, MW	1.8	A	注1
6	出力電流 (起動・加速時)	IOM	MU, MV, MW	1.8	A	注1
7	動作接合温度範囲	Tjop		-20 ~ +135		注2
8	保存温度範囲	Tstg		-40 ~ +150		

注1. 1Aを越える期間のデューティが通流期間の5%以下となる範囲でご使用下さい。

注2. 熱抵抗

1) 接合 - ケース間 $R_{jc} = 4 \text{ } / W$

2) 接合 - 周囲温度間 $R_{ja} = 40 \text{ } / W$

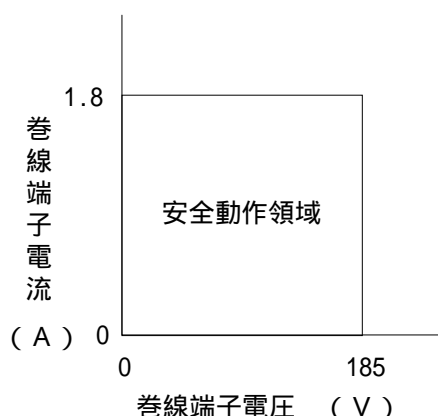
注3. 本ICは一時的電源誤接続を想定し、305V、1分間の耐量があります。

3. 推奨動作条件

No.	項目	記号	端子	MIN	TYP	MAX	単位	条件
1	電源電圧	VS	VS1, VS2	90	141	185	V	
2		VCC	VCC	13.5	15	16.5	V	

注1. 推奨安全動作領域

巻線端子の電圧・電流が相切替え時において下図の安全動作領域内となる範囲でご使用下さい。



ECN3061

4. 電気的特性 ($T_a = 25$)

特記条件を除き、 $V_{CC} = 15V$ 、 $V_S = 141V$ 。

記号添字 T は上アーム、添字 B は下アームデバイスを示します。

No.	項目	記号	端子	MIN	TYP	MAX	単位	条件
1	スタンバイ電流	IS	VS1, VS2	-	4.0	10	mA	UT, VT, WT, UB, VB, WB =0V
2		ICC	VCC	-	10	20	mA	
3	出力電圧降下	VFT	MU, MV, MW	-	2.0	3	V	I=0.7A
4		VFB	MU, MV, MW	-	2.0	3	V	I=0.7A
5	ターンオン遅延時間	TdONT	MU, MV, MW	-	0.5	3.0	μs	I=0.7A 抵抗負荷
6		TdONB	MU, MV, MW	-	0.5	3.0	μs	
7	ターンオフ遅延時間	TdOFFT	MU, MV, MW	-	1.0	3.0	μs	
8		TdOFFB	MU, MV, MW	-	0.8	3.0	μs	
9	還流ダイオード	VFDT	MU, MV, MW	-	2.0	2.5	V	I=0.7A
10	順電圧降下	VFDB	MU, MV, MW	-	2.2	2.7	V	
11	入力電圧	VIH	UT, VT, WT,	3.5	-	-	V	
12		VIL	UB, VB, WB	-	-	1.5	V	
13	入力電流	IIH	UT, VT, WT, UB, VB, WB	-	-	100	μA	入力=5V 注1 プルダウン抵抗
14	VB電源出力電圧	VB	CB	6.8	7.5	8.2	V	
15	VB電源出力電流	IB	CB	25	-	-	mA	$V_{LOAD}=0.1V$

注1 . プルダウン抵抗は約 200k です。

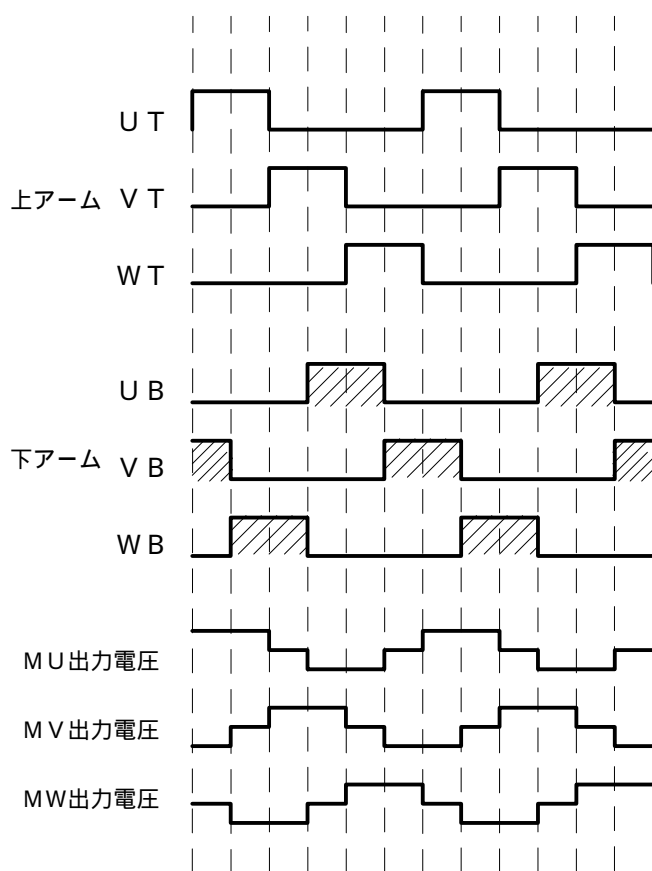
ECN3061

5. 機能、動作

5.1 真理値表

適用端子	入力	出力
UT, VT, WT, UB, VB, WB	L	OFF
	H	ON

5.2 タイムチャート



ECN3061

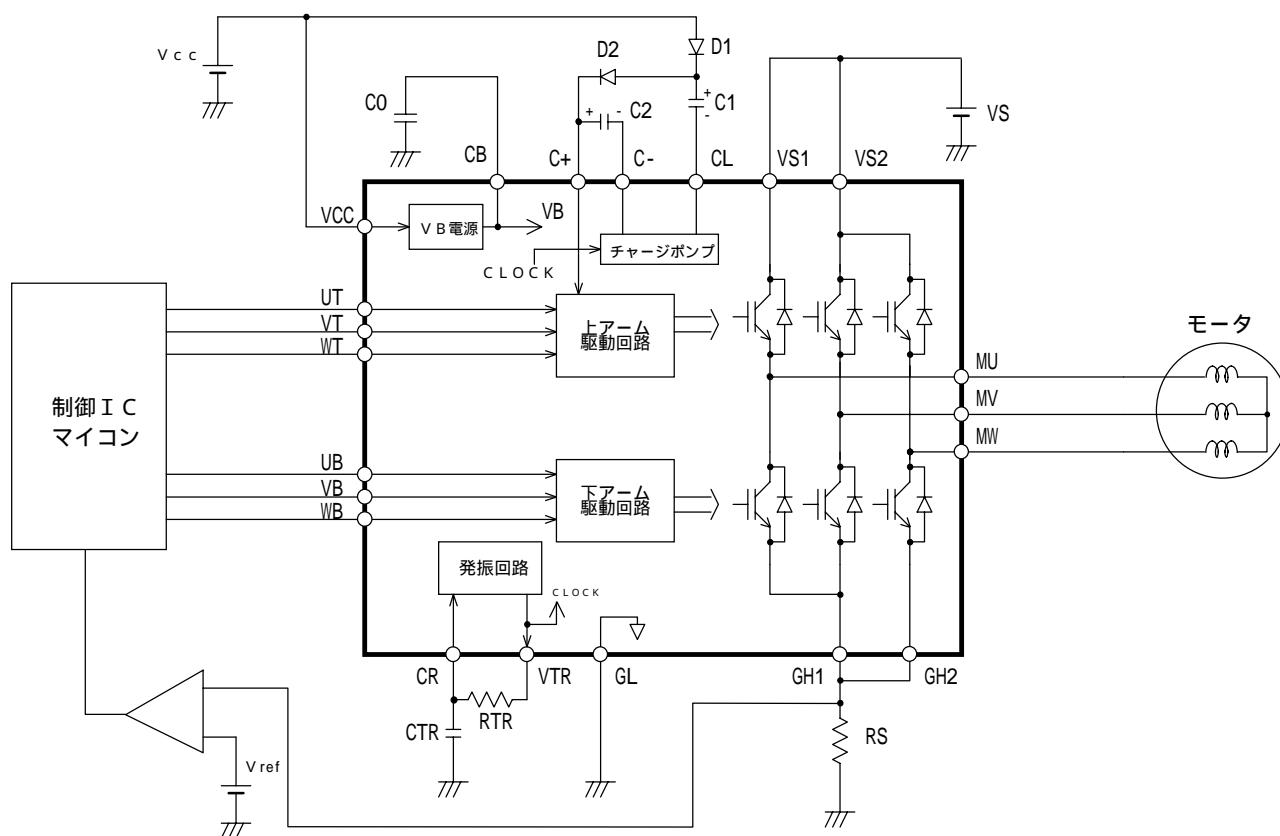
6. 標準アプリケーション

No.	部品	推奨値	目的	備考
1	C0	0.22 μ F 以上	内蔵V B 電源平滑用	ストレス電圧 8 V
2	C1,C2	1.0 μ F \pm 20%	チャージポンプ用	ストレス電圧はV c c
3	D1,D2	日立DFG1C4 (ガラスモールド)、DFM1F4 (レジンモールド) 又は相当品	チャージポンプ用	耐圧400V、1.0A定格 trr 100ns
4	CTR	1800 pF \pm 5%	クロック周波数設定用	注1
5	RTR	22 k \pm 5%	クロック周波数設定用	注1

注1. クロック周波数はおおむね次式で決まります。この際基板の浮遊容量に対する配慮が必要です。
推奨C R 値において、I C 固有の誤差要因は約10%です。

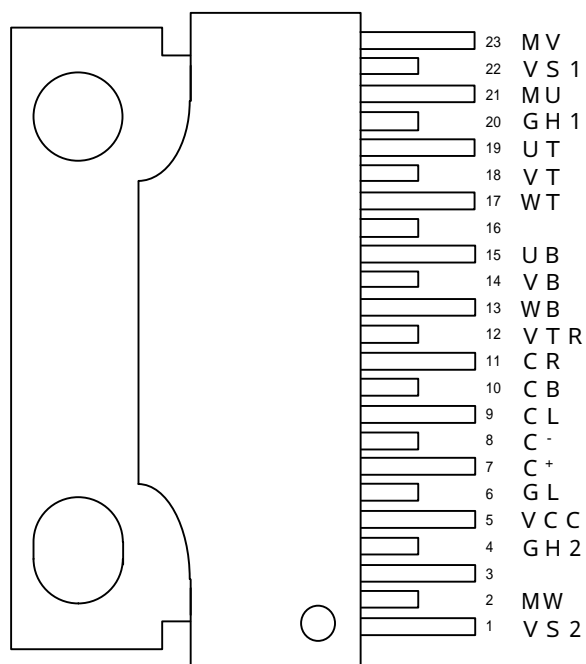
$$f_{\text{clock}} = -1 / (2C \cdot R \cdot \ln(1 - 3.5/5.5)) \quad ; \text{Ln は自然対数}$$

$$= 0.494 / (C \cdot R) \quad (\text{Hz})$$



ECN3061

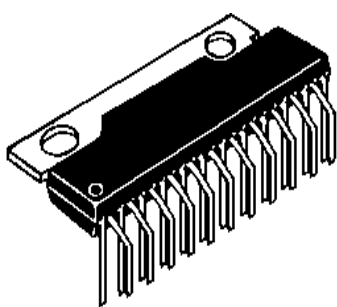
7. ピン配置



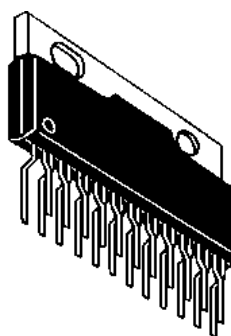
(型式マーキング面)

図2.ピン配置図

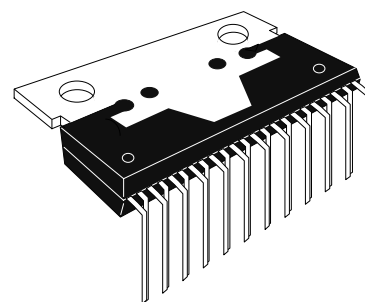
8. パッケージ外形



i) ECN3061SP



ii) ECN3061SPV

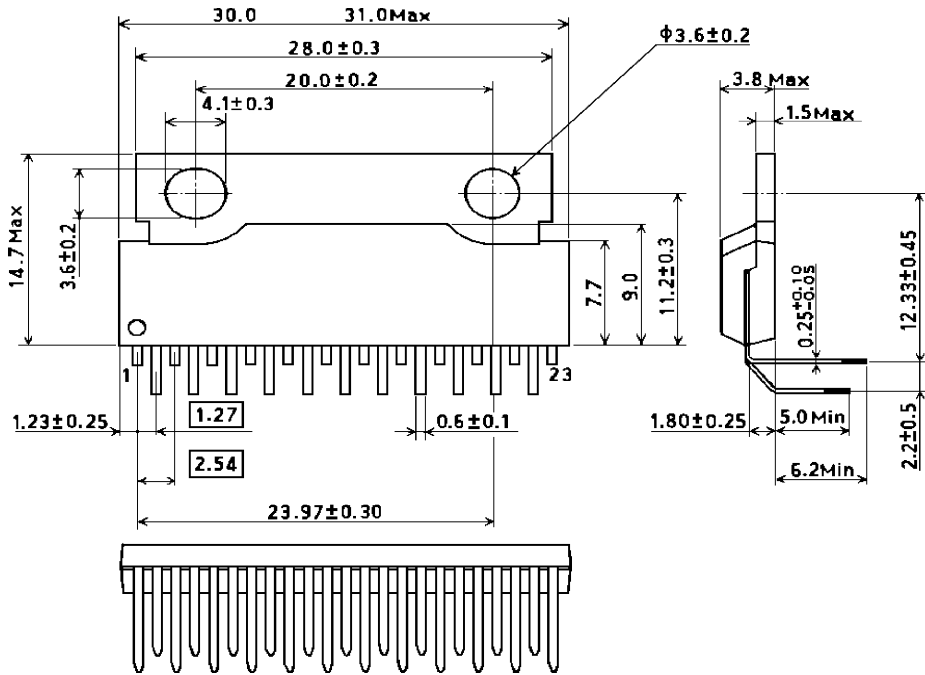


iii) ECN3061SPR

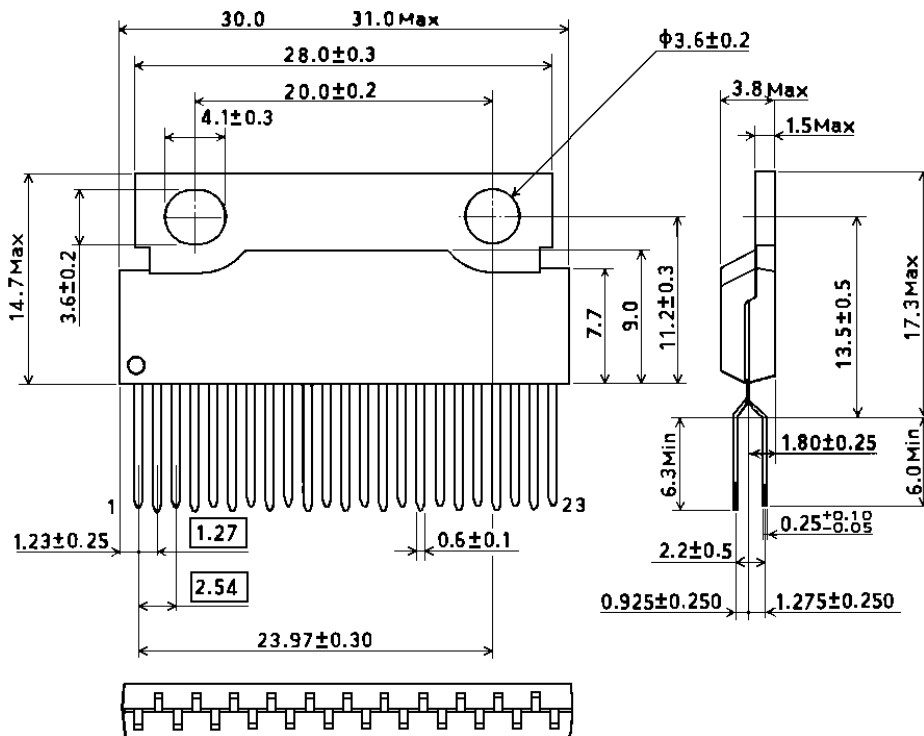
ECN3061

9. パッケージ外形寸法

i) ECN3061SP

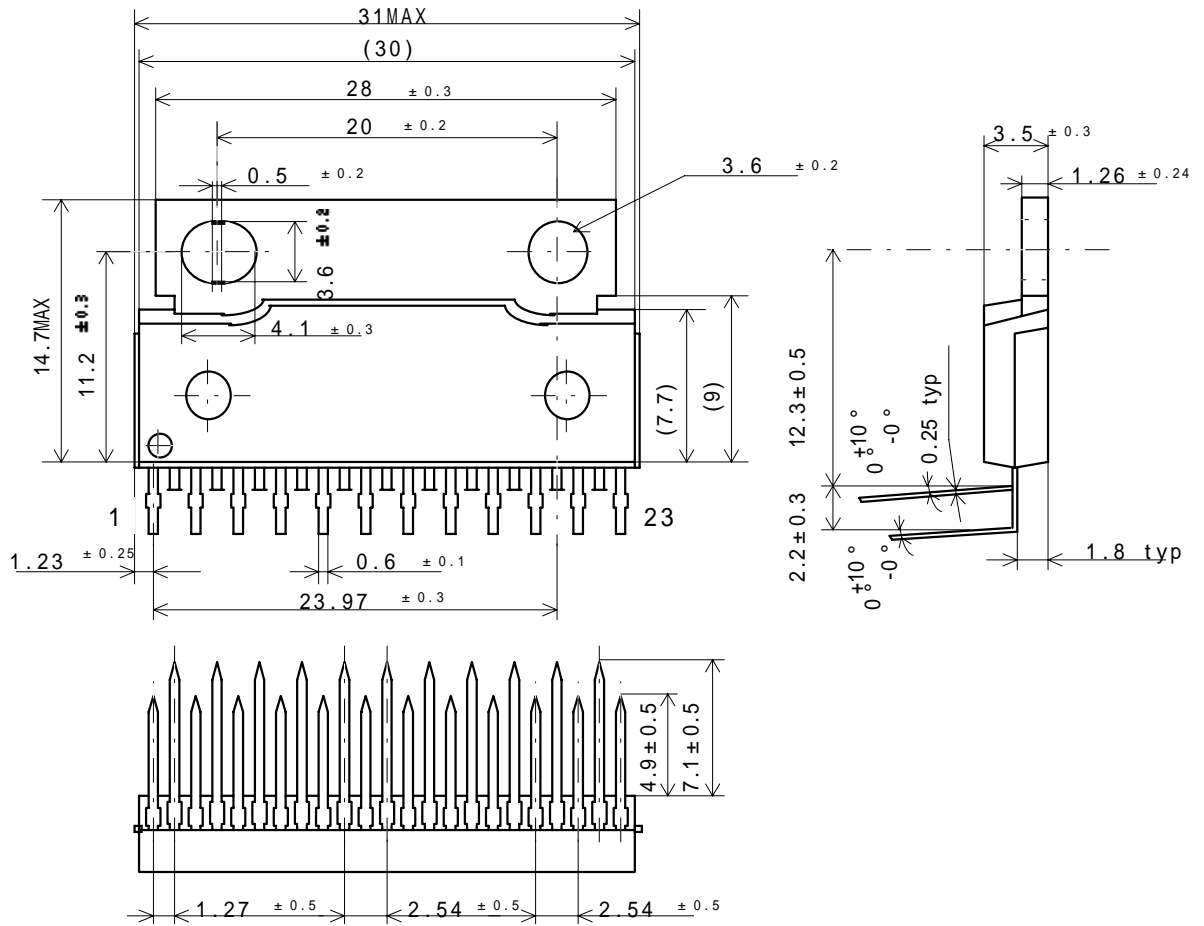


ii) ECN3061SPV



ECN3061

iii) ECN3061SPR



ご注意

- 1 . 本資料に掲載した内容は特性改善の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。ご検討の際は弊社営業所に最新のデータである事をご確認下さい。
- 2 . 製品ご使用の前に個別製品カタログの「安全上のご注意とお願い」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
- 3 . 極めて高い信頼性が要求される用途（原子力制御用、航空宇宙用、交通機器、ライフサポート関連の医療機器、燃焼制御機器、各種安全機器など）に使用される場合は、特に高信頼性が確保された半導体デバイスの使用及び使用側でフェイルセーフなどを配慮した安全性確保をして下さい。または当社営業窓口にご照会下さい。
- 4 . 本資料に記載された情報、製品や回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、株式会社日立製作所は一切その責任を負いません。
- 5 . 絶対最大定格値を越えてご使用された場合の半導体デバイスの故障及び二次的損害につきましては、弊社はその責任を負いません。
- 6 . 本資料によって第三者または株式会社日立製作所の特許権その他権利の一部を許諾するものではありません。
- 7 . 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製する事を堅くお断り致します。
- 8 . 本資料に記載された製品（技術）を国際的平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に再提供したり、またそのような目的に自ら使用したり第三者に使用させたりしないようにお願いします。なお、輸出などされる場合は外為法の定めるところに従い必要な手続きをおとりください。

製品に対する問い合わせは、ホームページのトップページにある「お問い合わせ先」の最寄りの営業所へどうぞ。

日立パワー半導体ホームページアドレス <http://www.pi.hitachi.co.jp/ps>